

# 一般整流ダイオード Rectifier Diode

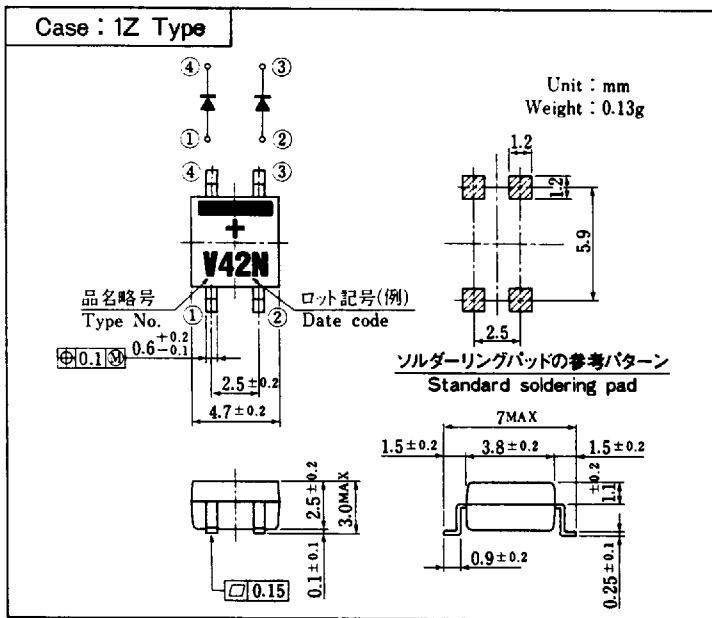
アレイ型 Diode Array

## S1ZA□

### 600V 1.1A



## 外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



## 定格表 RATINGS

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	S1ZA20	S1ZA40	S1ZA60	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T <sub>stg</sub>			-40~150			℃
接合部温度 Operating Junction Temperature	T <sub>j</sub>			150			℃
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V <sub>RM</sub>			200	400	600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I <sub>O</sub>	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, Ta=25℃	アルミナ基板実装 On alumina substrate	1回路通電 1 element operation	1.1		A
				2回路通電 2 elements operation	0.8*		
			プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	1回路通電 1 element operation	0.9		
				2回路通電 2 elements operation	0.63*		
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I <sub>FSM</sub>	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1 サイクルせん頭値, T <sub>j</sub> =25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, T <sub>j</sub> =50℃		30*		A	

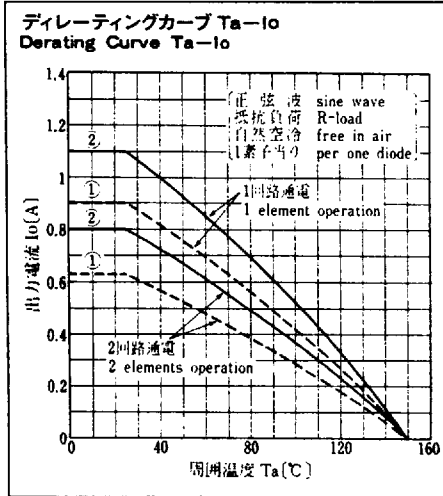
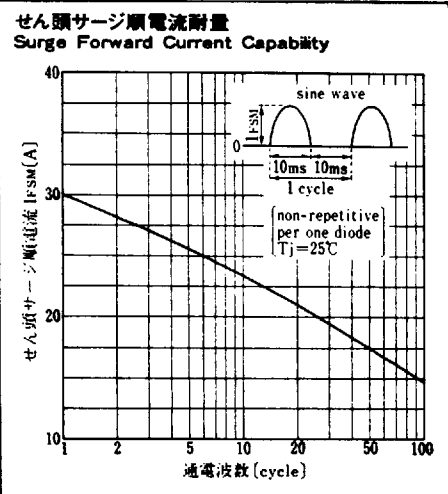
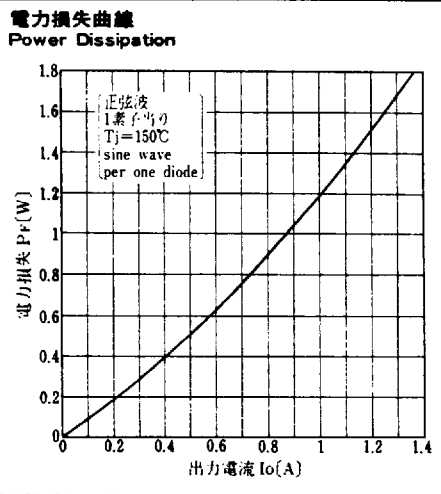
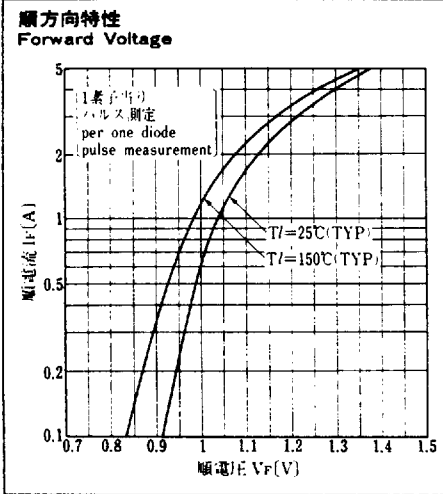
## 電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (T<sub>l</sub>=25℃)

順電圧 Forward Voltage	V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> =0.9A, パルス測定, 1 素子当りの規格値 I <sub>F</sub> =0.9A, Pulse measurement, Rating of per diode	MAX	1.1	V		
逆電流 Reverse Current	I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> =V <sub>RM</sub> , パルス測定, 1 素子当りの規格値 V <sub>R</sub> =V <sub>RM</sub> , Pulse measurement, Rating of per diode	MAX	10	μA		
熱抵抗 Thermal Resistance	θ <sub>ja</sub>	接合部・周囲間 Junction to ambient	アルミナ基板実装 On alumina substrate	1回路通電 1 element operation	MAX	93	℃/W
				2回路通電 2 elements operation	MAX	140*	
			プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	1回路通電 1 element operation	MAX	120	
				2回路通電 2 elements operation	MAX	186*	

\* : 1 素子当りの規格値

\* : Rating of per diode

■ 特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



	①プリント基板実装 on glass-epoxy substrate	②アルミナ基板実装 on alumina substrate
プリントランド soldering land	1 mm $\bar{\bar{}}$	1 mm $\bar{\bar{}}$
導体箔 conductor layer	35 $\mu\text{m}$	20 $\mu\text{m}$
基板の厚さ substrate thickness	—	0.64 mm